ポリエチレンテレフタレートの高電界伝導

前田昭徳* 小嶋憲三* 岡本省三*

High Field Conduction in Polyethylene Terephthalate.

Akinori MAEDA, Kenzo KOJIMA, Shozo OKAMOTO.

ポリエチレンテレフタレートは分子構造を変えることなしに,熱処理することにより簡単に結晶化度を 変化させることができる物質である.

これまで,結晶化度に対する物理的性質の依存性については多くの研究例がある.

本報では,高電界電気伝導と結晶化の関係について検討をした.その結果,ガラス転移温度以下の低温 領域での伝導機構は,電子的なものと考えられ,結晶化度の変化によって試料中のトラップに影響がみとめ られた.

まえがき

ポリエチレンテレフタレート(以下PET)の高電界電気伝導に関して多くの研究者により調べられている.た 1, 20 3)たえば Inuishi らと Amborski らによるイオン伝導 説, Lengyel は高電界伝導が Schottky プロットによ く一致すること, Lilly は J=Jo sinh aV (Jo, a は定 数)のイオン伝導の形に従わないことを述べ、少なくと も電流は Schottky 形か Poole-Frenkel 形であること を主張している.

本報告では電子的過程にもとずいてその伝導機構と結 晶化度依存性について検討した。その結果,PETの転 移温度(80°C)以上の高温領域と転移温度以下の低温 領域での伝導のしかたが異なることを見い出した。低温 領域では Poole-Frenkel 効果で,高温領域ではイオン による空間電荷層の影響が Poole-Frenkel 効果に加わ っているものと解釈した。また,結晶化度の効果は低温 領域で比較的顕著であることが判明した。

実験方法

2・1 試料:25µm厚の市販 PET フイルムを用い, これ を熱処理して実験用試料とした.熱処理方法としては, 200°C のシリコンオイル中で 1,5,8,10時間それぞれ 加熱したのち恒温槽内で約2時間かけて 除冷した もの と,シリコンオイル中より取り出し,メチルエチルケト ンに浸し急冷して結晶化度 を 変 化させた 試料を作成し

* 電気工学教室

た. 試料の洗浄はメチエルチルケトン中に2~3日浸したのち, ヘキサン, 中性洗剤および水で洗った.

2・2 測定:電極の構成および測定回路を図1に示す。



- 6) Coaxial Cable 7) Amper Meter
- 8) X—Y Recorder

電極としては銀ペイントを塗ったものと,銀を蒸着して 用いた. 直流電圧 100V~1,000V の範囲で変化させ,そ の時流れる電流をレコーダーで記録し,電流安定後の値 をデータとして用いた.また,相対的な結晶化度の測定 には赤外線吸収スペクトルにより結晶性バンドと非結晶 性バンドの比をとった.試料の結晶化度を表1に示す.

Sample Number	Crystallinity(%)
В	6 9.0
C - 1*	7 1.8
C -10*	74.2
<u> </u>	61.6
A:急冷試料	

表1 PET の結晶化度

B:未処理試料

C:除冷試料

*:急冷および除冷に要する時間を示す (時間)

3. 実験結果および考察

一般に, 誘電体に直流電圧を印加すると, 長時間にわ たって電流は減少し,一定時間を経過したのちに安定す る。この減衰電流は吸収電流と呼ばれ双極子の配向およ びイオンの巨視的移動によるものである.安定後の電流 値は、もれ電流と呼ばれている.本報告において測定範 囲内でこの吸収電流は1時間以内で安定する温度領域に ついて検討した。またこのもれ電流は電界を増加すると 電界にともなって増加し, この増加のしかたによって伝 導機構が特徴づけられる.

一般に、固体では ohmic な領域(低電界領域)と非 ohmic な領域(高電界領域)に分けられる.



Fig 2 LogJ—LogE 特性

図2に未熱処理試料の logJ—logE プロットの高電界 領域の特性を示してある。各温度にわたって,およそ 2×107 〔v/m〕 までの電界領域では2乗に, それ以上の 電界領域では,電流は電界に対してさらに高次に依存し ている。ガラス転移温度(約80°C)以下では、この傾向 は顕著である、しかし転移温度以上の高温領域では高電 界側で約2乗となり、この2領域を区別して取り扱う必 要がある、以上にのべた特徴は熱処理試料についてもほ ぼ同一の結果が得られている. 以下にこの高電界におけ る伝導機構を検討する. ここでこれまでに述べられてい る理論はキャリヤー別にみると(1)イオン伝導,(2)電子伝 導に区別される. イオン伝導の高電界特性は

J=Jo sinh aV

$pprox 1/_2 \cdot \operatorname{Jo}$	exp (AE)	(1)
但し Jo,	a, A は定数	

となり, logJ—E プロットをすれば直線で近似される. PET について, Inuishi ら, Amborski らにより高温 領域で(1)式に従うことを報告している。図3は(1)式にし たがって未熱処理試料の logJ-E プロットを示したも のである。明らかに測定値は(1)式を満足せず、測定温度 領域内ではイオン性伝導は否定的であり、電子的機構を 考慮しなければならない.



さて, 電子的な機構の内, (i)SCLC形, (ii)Schottky形 (iii)Poole-Frenkel 形の3つが本データを説明しうる可 能性があるので以下検討する.

ー般に,SCLC 形では低温領域において自由電子密度 が電極よりの注入電荷にくらべて少ないと高分子内に空 間電荷が形成され,電極からの注入が空間電荷で制御さ れた電流が流れる.

$$\mathbf{J} = -\frac{9}{8} \varepsilon \mu - \frac{\mathbf{V}^2}{\mathbf{d}^2}$$
(2)

ここで, e:誘電率(ε₀εr), V:印加電圧, d:試料厚

で示され、この電流は印加電圧の2乗に比例する Child 則を満たし、高分子内のトラップの存在状況により大き な影響をうける.高電界ではトラップがすべて埋められ ると電流は急増する現象が生じ、その後ふたたび Child 則に移行する.しかし低電界では熱励起された自由電子 密度があるため電流はオーム則で示される.図2に示さ れるように、低温領域では電圧の2乗以上の特性を示し ており、この理論の適用は困難であるが高温領域でほぼ 2乗則がみたされている.しかし、全測定領域での統一 的な解釈がこの理論では不十分である.

次に Schottky 形と Poole-Frenkel 形の伝導機構は 電界による電位障壁の低下にもとずいた理論であって電 極の実効仕事 関数を対象にしたのが Schottky 形であ り,次式で示される.

$J = AT^2 \exp\{(\beta_s E^{\frac{1}{2}} - \phi)/kT\}$	(3)
$\beta_{\rm s} = ({\rm q}^3/4\pi\varepsilon_{\rm o}\varepsilon_{\rm r})^{\frac{1}{2}}$	(3)'



ここで A:Dushman-Richardson 定数, co:真空の誘 電率, φ: 電極の仕事関数

試料内に適用したものが Poole-Frenkel 効果であり (4)式で示される.

$$\sigma_{\rm PF} = \sigma_{\rm o} \exp\{(-U + \beta_{\rm PF} E^{\frac{1}{2}})/2kT\}$$
(4)

$$\beta_{\rm PF} = (q^3 / \pi \varepsilon_{\rm o} \varepsilon_{\rm r})^{\frac{1}{2}} \tag{4}$$

ここでσ。:低電界の導電率, U:トラップの深さ. これらは同一機構によるものである.





図6 急冷試料の logσ-//E 特性

Lengyel $^{40}_{41}$ PET の高電界特性を Schottky 形である ことを述べ、また、Lilly は少なくとも電流が Schottky 形か Poole-Frenkel 形であることを主張している. こ の理論は(3), (4)式からlogJ, $\log \sigma o_{1}\sqrt{E}$ 特性をプロット すると直線で与えられる. Schottky プロットを図4に 示す. 高電界側では、ほぼ直線で近似できる. 図には示 してないが、Au, Al 電極による実験では、電極効果は みとめられなかった.また、(3)式の温度特性である logJ/T²—1/T プロットを図5に示す.一般的に、この 特性は直線で示されるが測定値は曲線となり、この理論 も本データを説明するにはいたらない.



つぎに、図6、図7に冷急と除冷 試 料の(4) 式からの log $\sigma - \sqrt{E}$ プロットを示す。両試料とも高温,低温領域 を通して(4)式の関係を非常によく満たしている。この傾 き β_{PF} は(4)、式で与えられ、 $\epsilon_r=3.2$ とすると $\beta_{PF}=6.80 \times$ 10⁻²⁴ [cv^½・m^½] となりほぼ実測値と一致する。

Poole-Frenkel 式の傾きは一般に β_{PF}/kT で与えられ るが田中らは、ポリエチレン、ポリカーボネートについ てバルク中に浅いトラップと深いドナーを 考えた 場合 に、傾きは $\beta_{PF}/2kT$ になることを示した.

図8に(4)式の直線の傾き $4\log\sigma/4\sqrt{E}$ および 0.434 $\beta_{PF}/2kT$ の 1/T 特性を示す. 各試 料に 対する実 測値 は,ほぼ(4)式の理論値と一致し傾きもほぼ同様な温度特 性を示す.したがって本試料の PET の高電界伝導でも 結晶—非晶領域界面および結晶領域内のみだれなどのト ラップ効果,ドナーとしての不純物等を考慮する必要が



ある. このことは図8が結晶化度とともに傾きが大きく なっていることと関係があると思われるが詳細について は不明で,現在熱刺激電流(TSC)の解析により検討を している. 図8の関係は(4)式の温度依存性をとることに よってさらに明確に示される. これを図9に示す. 直線 の傾きは $\frac{1}{2k}$ ($-U + \beta_{PF} \sqrt{E}$)で示され,低温領域の それにくらべ高温領域では5倍ほど大きくなっている. したがって Poole-Frenkel 効果で伝導機構を説明して きたが,低温領域と高温領域での伝導過程がまったく同

一のものと考えることができない。

普通,有機固体ではガラス転移温度以上では分子運動 が非常に容易となり特に PET では高温でイオン性のキ ャリヤーが豊富となる.高温領域ではこれらのイオンが キャリヤーとしてのふるまいと,空間電荷層の形成によ る影響がかさなってくるためと考えられる.

先にのべたAmborski らはイオン伝 導の根 拠として 結晶化度の増加によって導電率と活性化エネルギーは低 下することを述べている.しかし本実験の結果では導電 率は結晶化度とともに低下しているが傾きは大きくなっ ている.このことは熱処理による結晶化の進行過程で結 晶内の欠陥および結晶一非晶界面などの比較的深いレベ ルにトラップされた電子の熱放出がきいてくるためと考 えられる. 最後に、この紙面をおかりして、 IR 等の測定で御助 力下さいました、応用化学科助教授稲垣慎二氏に御礼申 し上げます.

文 献

- 1) 犬石, D.A. Powers: 電学誌, 77, 1072 (昭32)
- 2) Y.Inuishi & D.A.Powers: J.Appl.Phys.,28, 1017 (1957)
- 3) L.E.Amborski: J.Polym.Sci., 62,331 (1962)
- 4) G.Lengyel: J.Appl.Phys., 37, 807 (1966)
- A.C.Lilly, Jr.& J.R.McDowell: J.Appl. Phys, 39, 141 (1968)
- 6) 田中, 犬石: 電学誌 **89**, 75 (昭44)